グラファイト表面におけるキセノン原子散乱挙動の分子動力学的解析

Molecular Dynamics Study of Xe Scattering from a Graphite surface

\bigcirc	正	山口 浩樹 (東大・コ	_)	正畠 宏祐 (*	名大・コ	L) 渡	度部 佳優 ((名大・	工院)
	正	松本洋一郎 (東大・	工) 正	丸山 茂夫 ()	東大・コ	_)			
	Hirol	ti YAMAGUCHI,	The Uni	versity of To	okyo, Ho	ongo,	Bunkyo, 7	Fokyo	
	Kosu	ke SHOBATAKE,	Nagoya	University,	Fu	ro-ch	o, Chigusa	a, Nago	oya
	Yosh	imasa WATANABE,	Nagoya	University,	Fu	ro-ch	o, Chigusa	a, Nago	oya
	Yoich	iro MATSUMOTO,	The Uni	versity of To	okyo, Ho	ongo,	Bunkyo, 7	Fokyo	
	Sigeo	MARUYAMA,	The Uni	versity of To	kyo, Ho	ongo,	Bunkyo, 7	Fokyo	

Recently accurate results of Xe scattering from graphite have been obtained; 1) the Xe angular distribution is peaked below the specular direction and becomes narrower as the incident energy increases, and 2) the direct scattering channel becomes dominant for high incident energies. Molecular scattering simulations have been employed to investigate these observations. We have employed the Brenner type intraplanar interaction potential and the Lennard-Jones potential for the interplaner interaction. From the numerical analyses, it becomes clear that the layered structure of graphite is responsible for the observed collision dynamics. The MD simulations reproduce the experiment for a wide range of initial conditions.

Key Words: Gas-Surface Scattering, Molecular Beam, Molecular Dynamics

1 緒言

超高真空下における分子線散乱実験は,気体 - 固体表面間相 互作用に対する知見を得る非常に有効な手段である.分子線散 乱実験では,散乱分布,適応係数,吸着脱離過程など様々な情 報を得ることができ,表面散乱,反応の基礎的な理解を深める ことができる.しかし,衝突時のエネルギー伝達などの詳細な メカニズムまでを明らかにするのは難しい.数値実験を行うこ とで,理想的な条件において現象の本質を抽出しその詳細なメ カニズムを明らかにすることが可能となる.

最近,気体原子にキセノン(Xe),固体表面にグラファイト を用いた分子線散乱実験^[2]において以下の知見が得られた^[3]. 入射エネルギーを大きくするほどピーク散乱角が大きくなるも ののある値に漸近し,その後は散乱分布拡がり幅が小さくなる ということである.そこで,分子動力学法を採用し,超高真空 下における分子線散乱実験を数値的に詳細に解析した.

2 数値計算手法

2.1 分子動力学法 分子動力学法を用いて, Xe 原子がグラファイト表面に衝突し, 散乱する系の数値解析を行った^[1].時間積分は Leap-Frog 法によって行い,時間刻みは 0.1fs とした.

グラファイトは,まず表面のミラー指数が (0001) となるように配置し,層内方向には周期境界条件を課すことで無限に広がる薄膜を再現する.計算領域内には1層の原子数を96個とし,考慮する層の数は6とした.その後,50,000ステップの温度制御後に50,000ステップ間,自由に炭素(C)原子を運動させ,熱平衡状態を再現させた初期状態を構築する.表面温度は実験条件に合わせ $T_s = 300$ K及び550Kとした.

入射原子に関しては入射角 $\theta_i = 15^\circ, 35^\circ, 60^\circ$ であり,入射 速度は実験によって測定された入射分子線の TOF 分布に従っ て確率的に選択した.入射した原子数は 10,000 である.入射 位置及び平面内入射方向はランダムとした.

2.2 ポテンシャル ポテンシャルは,以下のものを用いた.

まず, Xe 原子とグラファイト表面を構成する C 原子間には Lennard-Jones (12-6) ポテンシャルを採用した. Xe-C 対間の パラメータ $\epsilon = 8.455$ meV ,及び $\sigma = 3.233$ Å は,表面上に形 成される物理吸着ポテンシャル井戸の深さ 132.1meV ,表面か らの距離 3.34Å[5] を再現するように定めた.

グラファイト表面を構成する同一層内の C 原子間のポテン シャルとして Brenner ポテンシャル^[4] を採用した.

$$E_{b} = \sum_{i} \sum_{j(>i)} \left[V_{R}(r_{ij}) - \overline{B}_{ij} V_{A}(r_{ij}) \right]$$
(1)

ここで用いられている $V_R(r)$, $V_A(r)$ はそれぞれカットオフ 関数 f(r)を含む Morse 型の反発力及び引力項である.

$$V_{R}(r) = f(r) D_{e} \frac{1}{S-1} \exp\left\{-\sqrt{2S}\beta(r-R_{e})\right\}$$
(2)

$$V_A(r) = f(r) D_e \frac{S}{S-1} \exp\left\{-\sqrt{\frac{2}{S}\beta(r-R_e)}\right\}$$
(3)

$$f(r) = \begin{cases} 1, & r < R_1 \\ \frac{1}{2} \left(1 + \cos \frac{r - R_1}{R_2 - R_1} \pi \right), & R_1 < r < R_2 \\ 0, & R_2 < r \end{cases}$$
(4)

 \overline{B}_{ij} は結合 i-j と隣り合う結合 i-k とのなす角度 heta の結合 状態を表わすよう,引力項にかかる係数となっている.

$$\overline{B}_{ij} = \frac{1}{2} \left(B_{ij} + B_{ji} \right) \tag{5}$$

$$B_{ij} = \left[1 + \sum_{k(\neq i,j)} G_i\left(\theta_{ijk}\right) f_{ik}\left(r_{ik}\right)\right]$$
(6)

$$G_C(\theta) = a_0 \left(1 + \frac{c_0^2}{d_0^2} - \frac{c_0^2}{d_0^2 + (1 + \cos \theta)^2} \right)$$
(7)

ポテンシャルパラメータは, Ref. [4] のパラメータ *II* を用いた. 異なる層の C 原子間の van der Waals ポテンシャルとしては Lennerd-Jones ポテンシャルを用いた.ポテンシャルパラメー タは, $\epsilon = 2.40$ meV, $\sigma = 3.37$ Å とした.

また,グラファイトの層状構造の特性を明らかにするために,二体間調和振動ポテンシャルも採用し,比較を行った.

$$\phi(r_{ij}) = \frac{1}{2}K(r_{ij} - r_e) \tag{8}$$

K および r_e は , それぞればね定数 , 平衡時の原子間距離であり , C原子の相対的な位置により異なった値をとる .ポテンシャル係数 は Cohen^[6] 同様 , 同一層内際近接原子間で $K = 44.44 \text{eV}/\text{Å}^2$, $r_e = 1.42\text{Å}$, 隣接層内最近接原子間では $K = 6.39 \text{eV}/\text{Å}^2$, $r_e = 3.40\text{Å}$, 隣接層内第二近接原子間で $K = 2.13 \text{eV}/\text{Å}^2$, $r_e = 3.68\text{Å}$ とした .

3 計算結果及び考察

3.1 実験との比較 数値解析の結果を,入射原子の速度ベクトルと散乱原子の速度ベクトルから散乱方向を求め,整理した. 方位角が ±2.5°の範囲に入る原子を In-plane に散乱した原子として扱う.この原子に対し,天頂角を 5°刻みで ±2.5°に入る原子数をその方向の流束強度とし,最大値で規格化した.また,その原子が持つ運動エネルギーを平均化したものをその方向の散乱原子のエネルギーとした.

その散乱角度分布を示したのが, Fig. 1 である.ここでは, 代表的なものとして $T_s = 550$ K の場合で入射エネルギー,入射 角が異なる4条件の結果を示す.Brenner ポテンシャルを用い た結果が実験をよく再現していることが見て取れる.一方,調 和振動子ポテンシャルを用いると鏡面反射方向に鋭いピークが 現れ,実験結果とは大きく異なる.これは,グラファイトのも つ層状構造,そして層間の弱い結合を十分に再現できていない ことによると考えられる.そこで,人工的にグラファイトの層 内,層間ポテンシャルにそれぞれ,Brenner,調和振動子,及 び調和振動子,LJのポテンシャルを用いた場合の比較を行った. その結果,層間にLJポテンシャルを用いることでほぼ実験の 散乱角度分布を再現できることが明らかとなり,層間の弱い結 合が重要であることが分かった.

また,散乱原子の持つエネルギー分布を実験と比較した.代表的な結果として, $\theta_i = 35^\circ$, $T_s = 550$ K, $E_i = 3.50$ eV の条件の結果を Fig. 2 に示す.若干,実験に比べ低めに出て いるが,サンプル数の多い散乱角度分布のピーク位置付近では かなり傾向を捉えられている.入射エネルギーに比べ散乱原子 のエネルギーは小さく,グラファイトの弱い層間結合によって 効率的にエネルギーが固体側に逃げていることが分かる. **3.2** エネルギー伝播 詳しく衝突過程を解析するために,1 衝突に着目してエネルギー伝播の過程を見た.グラファイトの ポテンシャルを層内,層間で様々に変化させて比較検討した.そ の結果,上に述べた結果を支持するような過程が見られた.つ まり,層間に弱いLJポテンシャルを用いると,衝突時にグラ ファイトが"トランポリン"のようにシート全体で変形し,大 きなエネルギーを得ることが分かった.

4 結言

キセノンのグラファイト表面からの散乱過程を分子動力学法 を用いて解析した.その結果,実験の散乱角分布をよく再現す ることができた.また,ポテンシャルの比較検討の結果,グラ ファイトの層状構造及び層間の弱い結合がこの現象を引き起こ していることを明らかにした.

参考文献

- (1) 松本洋一郎・山西伸宏, 機論, 62-595, B (1996), 880-887.
- (2) Yoshikawa, H. et al., Rev. Sci. Inst., 70-3 (1999), 1806-1815.
- (3) Shobatake, K. et al., private communication.
- (4) Brenner, D.W., Phys. Rev. B, 42 (1990), 9458-9471.
- (5) Beran, S., Dubský, J. and Slanina, Z., Surf. Sci., 79 (1979), 39-52.
- (6) Cohen, L.C., J. Chem. Phys., 99 (1993), 9652-9663.



Fig. 1: Angular distribution of scattered Xe flux



Fig. 2: Angular distribution of scattered Xe energy:(b) 35deg., 550K, 3.50eV